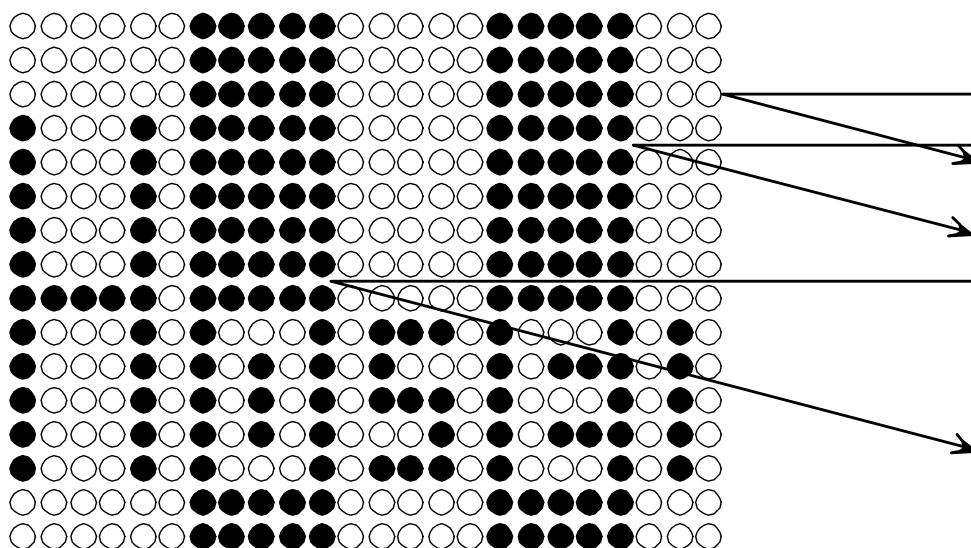


第 29 回法政大学  
イオンビーム工学研究所シンポジウム

The 29th Symposium on Materials Science and Engineering  
Research Center of Ion Beam Technology  
Hosei University

PROGRAM



期日 2010年12月8日(水)  
会場 法政大学 小金井キャンパス  
主催 法政大学イオンビーム工学研究所

I	10 : 30~12 : 00
<b>招待講演 I</b>	
レーザーの宇宙、環境、エネルギー分野への新展開 理化学研究所	(45分) 和田 智之
<b>招待講演 II</b>	
量子ビームで先導する先端プロセス・計測技術 京都大学*、JST-CREST**	(45分) 松尾 二郎*,**
昼食	12 : 00~13 : 00
II	13 : 00~14 : 20
<b>招待講演 III</b>	
針葉樹型カーボンナノ構造体を用いた可搬型 X 線源 産業技術総合研究所	(45分) 鈴木 良一
<b>招待講演 IV</b>	
炭素系電界放出電子源を用いた超小型 X 線管 鬼塚硝子	(35分) 中村 智宣
休憩	14 : 20~14 : 30
III ショート講演 (各 5 分)	14 : 30~15 : 25

- 低速多価イオン照射 GaN 表面からの水素の選択的脱離  
東洋大学 ○本橋 健次
- 高温イオン注入による SiO<sub>2</sub>/Si 界面への Fe 微粒子の形成と RBS・TEM による評価の研究  
神奈川大学 ○星野 靖、有馬 広記、斎藤 保直、中田 穰治
- 低速電子線回折・走査型トンネル顕微鏡を用いた Si・グラファイト表面観察  
—装置立ち上げの記録—  
神奈川大学 ○梶原 覚、山口 将輝、星野 靖、斎藤 保直、中田 穰治
- ダイヤモンド Ib 基板のホール効果測定法による電気的評価  
神奈川大学 ○本杉 太郎、星野 靖、斎藤 保直、中田 穰治
- 高温イオン注入による SiO<sub>2</sub>/Si 界面への Co クラスタ形成と断面 TEM 観察を中心とした評価の研究  
神奈川大学 ○横山 愛、有馬 広記、星野 靖、斎藤 保直、中田 穰治
- ホットイオン注入形成微粒子を種触媒とする CNT 生成法の研究  
神奈川大学 ○有馬 広記、星野 靖、斎藤 保直、中田 穰治
- Extended defect observations in B-doped (001) homoepitaxial diamond films by EBIC and CL combination technique  
Comet, Inc., NIMS\*, AIST\*\*  
○Sung-Gi Ri, Takashi Sekiguchi\*, Hideyo Okushi\*\*, and Satoshi Yamasaki\*\*
- 粒子線誘起ガンマ線分光 (PIGE) による固体高分子型燃料電池排出物中のフッ素 (F) 分析  
東京工業大学、東京都市大学\* ○川崎 克則、服部 俊幸、鳥山 保\*、小野田 充\*、  
大坪 史明\*、木村 高士\*、武 哲夫\*、高木 靖雄\*、実吉 啓二、小栗 慶之
- スパッタリングによる AlN:Eu,Si 薄膜の作製と PL 評価  
明治大学 ○平沼 智彦、吉村 啓佑、勝俣 裕、植草 新一郎

10. 反応性スパッタリング法で作製した TaN 薄膜の結晶構造と電気抵抗  
明治大学 ○田島 裕章、田中 徹、勝俣 裕、植草 新一郎

11. Er および Yb を添加した nc-Si/SiO<sub>2</sub> 薄膜の PL 発光特性  
明治大学 ○大内 慎也、古森 祐樹、渋谷 洋貴、勝俣 裕、植草 新一郎

**休憩** **15 : 25~15 : 35**

**IV ポスターセッション** **15 : 35~16 : 45**

12. Al イオン注入 ZnO バルク単結晶の低抵抗化の起源  
ーラザフォード後方散乱および核反応分析による格子変位の評価ー  
法政大学、大阪教育大学\*、産業技術総合研究所\*\*  
○井澤 佑介、尾賀 孝宏、栗山 一男、串田 一雅\*、木野村 淳\*\*

13. 各種 ZnO 単結晶基板上的 GaN 初期成長膜界面のラザフォード後方散乱法による評価  
法政大学、福井大学\*、沖電気工業\*\* ○井澤 佑介、尾賀 孝宏、伊田 貴寛、  
栗山 一男、橋本 明弘\*、小竹 弘倫\*、上條 健\*\*

14. Characterization of silicon ion-implanted GaN and AlGaN  
法政大学 ○Kazuki Nomoto, Yuki Toyoda, Masataka Satoh, and Tohru Nakamura

15. 自己整合型シリサイドゲートノーマリーオフ GaN MISFET に関する研究  
法政大学 ○田口 真也、長谷川 一也、野本 一貴、中村 徹

16. Si イオン注入 GaN HEMT の高周波特性  
法政大学、山梨大学\* ○片寄 秀雄、大田 理奈雄、野本 一貴、小野島 紀夫\*、中村 徹

17. Mg-doped GaN 上への Pd 系オーミック電極の形成及び電気特性評価  
法政大学 ○内野井 麻菜、野本 一貴、中村 徹

18. プラズマ表面処理による 4H-SiC ショットキーバリアダイオードの特性改善効果  
法政大学 ○杉本 尚丈、西村 智朗、佐藤 政孝、中村 徹

19. アルミニウムイオン注入 4H-SiC 層電気特性の熱処理依存性  
法政大学 ○中村 善、平賀 祐作、田島 卓、西村 智朗、佐藤 政孝、中村 徹

20. 低濃度 Al 注入 4H-SiC の不純物分布  
法政大学 ○斎藤 友紀雄、西村 智朗、中村 徹

21. 4H-SiC を用いた p-n 接合ダイオード特性のプラズマ処理効果  
法政大学 ○大田 浩之、杉本 尚丈、田島 卓、西村 智朗、佐藤 政孝、中村 徹

22. スパッタリング法により形成した Al 添加 CeO<sub>2</sub> 薄膜の結晶化温度  
法政大学 ○浅野 慶太郎、野沢 大地、蒲田 大生、佐藤 義也、鈴木 悠、山本 康博

23. H<sub>2</sub>O 導入 MOCVD 法による CeO<sub>2</sub> 薄膜形成時の反応機構  
法政大学、コメント\* ○木樽 智也、伊豆 崇則、島田 洋希、多田 直裕、土屋 学、  
笠井 隆光、下村 崇広、鈴木 撰\*、山本 康博

24. ペンタセン有機薄膜への C イオン照射効果  
法政大学 ○矢部 智久、坂本 優貴、西村 智朗、佐藤 政孝

25. Co/Cu 多層膜のイオン照射効果

法政大学、産業技術総合研究所\*、島根大学\*\*

○岡寄 聡、樺田 尚大、坂本 勲、小池 正記\*、本多 茂男\*\*

26.  $^{57}\text{Fe}$  イオン、Au イオン連続注入  $\text{Al}_2\text{O}_3$  の構造と磁気特性

法政大学、久留米工業大学\*、東京大学\*\*、島根大学\*\*\*、東京都市大学\*\*\*\*

○木下 量介、坂本 勲、林 伸行\*、野村 貴美\*\*、本多 茂男\*\*\*、石田 智也、  
飯尾 智\*\*、田代 博之\*、鳥山 保\*\*\*\*

---

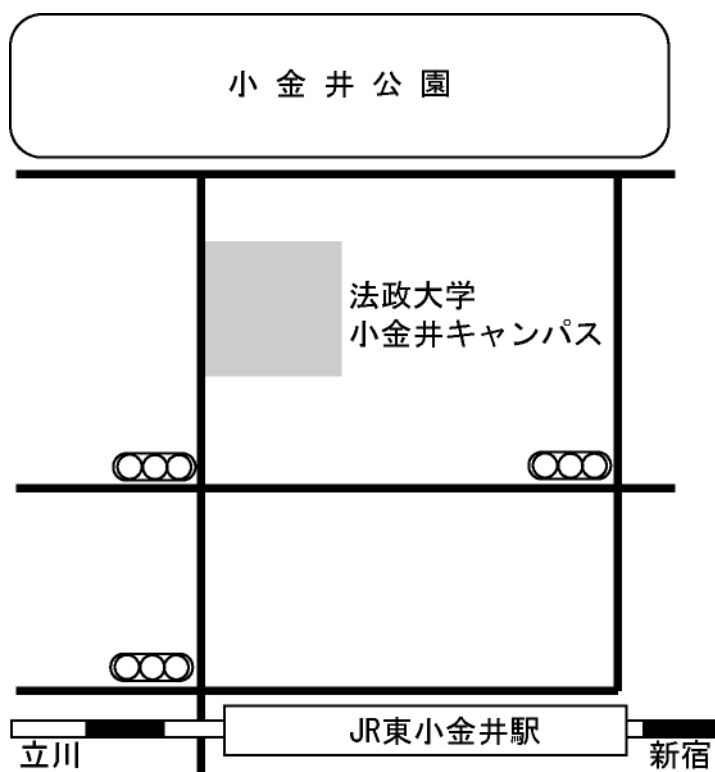
17:00~

懇親会

管理棟 1F 教職員食堂にて

---

交通案内



JR 東小金井駅北口より徒歩12分  
京王バスまたは CoCo バス「法政大学」下車

法政大学イオンビーム工学研究所

〒184-8584 東京都小金井市梶野町 3-7-2

Tel: 042-387-6094 Fax: 042-387-6095

E-mail: sympo@ionbeam.hosei.ac.jp